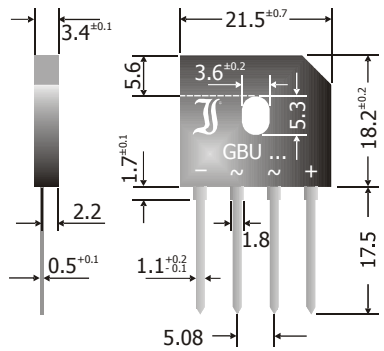
GBU8A ... GBU8M

Silicon-Bridge-Rectifiers
Silizium-Brückengleichrichter

Version 2010-03-31



Dimensions - Maße [mm]

Nominal current Nennstrom	8 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	35...700 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	20.8 x 3.3 x 18 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	7 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	

Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings **Grenzwerte**

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] [1])
GBU8A	35	50
GBU8B	70	100
GBU8D	140	200
GBU8G	280	400
GBU8J	420	600
GBU8K	560	800
GBU8M	700	1000

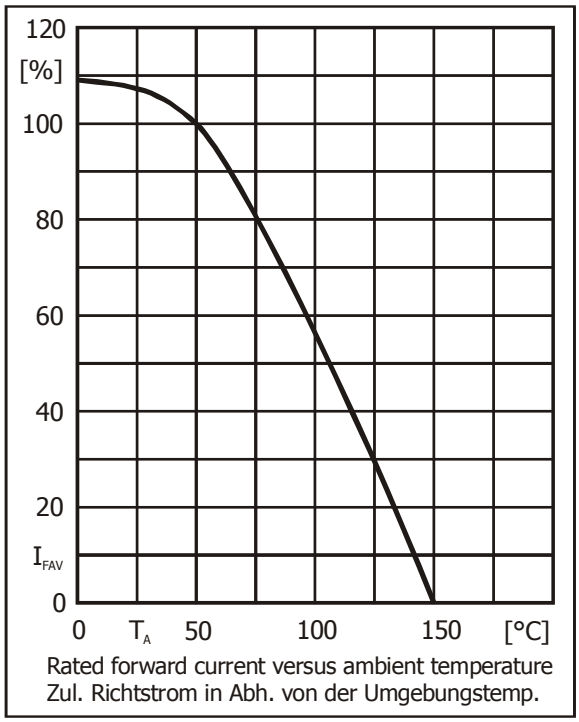
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I_{FRM}	50 A [2])
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25°C	I_{FSM}	270/300 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms	T_A = 25°C	i^2t	375 A^2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment	M3		9 ± 10% lb.in. 1 ± 10% Nm

1 Valid per diode – Gültig pro Diode
2 Valid, if leads are kept at ambient temperature T_A = 50°C at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur T_A = 50°C gehalten werden

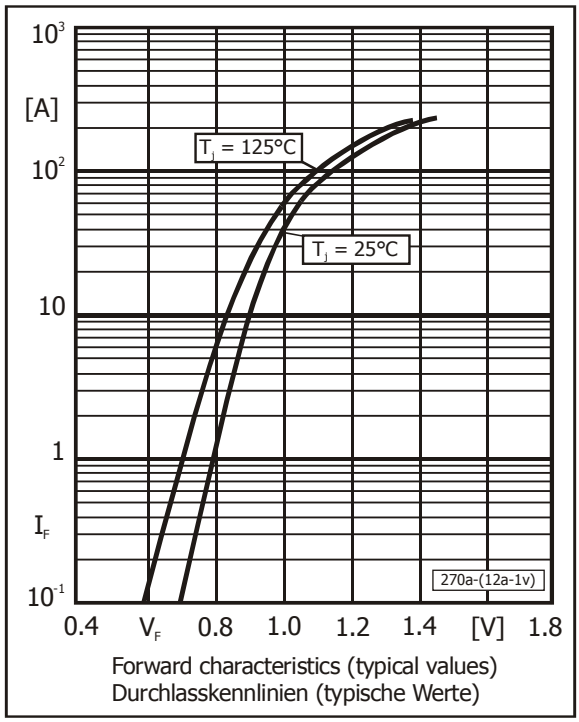
© Diotec Semiconductor AG

Characteristics				**Kennwerte**
Max. rectified current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kühlblech	T_A = 50°C	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	5.6 A [1]) 4.5 A [1])
Max. rectified current with cooling fin 300 cm² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm²	T_A = 50°C	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	8.0 A 6.4 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	T_j = 25°C	I_F = 8 A	V_F	< 1.0 V [2])
Leakage current – Sperrstrom	T_j = 25°C	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 3.0 K/W

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator C_L [µF]	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand R_t [Ω]
GBU8A	20000	0.2
GBU8B	10000	0.4
GBU8D	5000	0.8
GBU8G	2500	1.6
GBU8J	1500	2.4
GBU8K	1000	3.2
GBU8M	800	4.0



Rated forward current versus ambient temperature
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature T_A = 50°C at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur T_A = 50°C gehalten werden
2 Valid per diode – Gültig pro Diode

© Diotec Semiconductor AG